

IM70A135V01

- Technical documents
- Kits and boards
- Support

英飞凌高性能模拟 XENSIV™ MEMS 麦克风

特性

- 高性能模式下的超低电流消耗 (170µA)
- 低功耗模式下电流消耗低至 70µA
- 信噪比为 70dB(A) SNR
- 声过载点 (AOP) 为 135dB SPL
- 平坦的频率响应, 低频截止频率 (LFRO) 为 37Hz
- 封装尺寸: 3.50mm x 2.65mm x 1.00mm

- ✓ RoHS
- Green
- Halogen-free

潜在应用

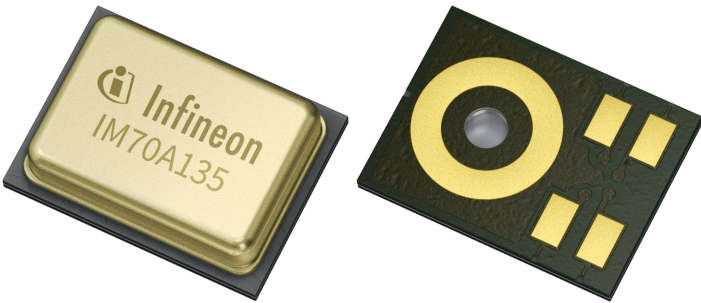
- 主动降噪 (ANC) 耳机和无线耳塞 (TWS)
- 具有语音用户界面 (VUI) 的设备
 - 智能音箱
 - 智能家居
 - 物联网设备
- 高品质音频采集
 - 会议系统
 - 相机和摄像机
- 具有音频检测功能的工业或家庭监控

产品验证

符合工业应用的技术。
通过 IEC 60747 和 60749 或 JEDEC47/20/22 的相关测试, 符合工业应用的验证标准。

描述

英飞凌 XENSIV™ MEMS 模拟差分麦克风 IM70A135V01 是一款紧凑型高性能麦克风, 具有高达 135 dB SPL 的声学过载点。该麦克风基于英飞凌全新的密封双膜 MEMS 技术, 可提供麦克风级别的高防护等级 (IP57)。小巧的尺寸使其特别适合 TWS 耳机应用。



Type	Package	Marking
IM70A135V01	PG-TLGA-5-5	I70A13

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见, 英飞凌提供了译文; 由于翻译过程中可能使用了自动化工具, 英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性请务必访问 [infineon.com](https://www.infineon.com) 参考最新的英文版本 (控制文档)。

目录

	特性	1
	潜在应用	1
	产品验证	1
	描述	1
	目录	2
1	框图	3
2	典型的麦克风接口	3
3	典型性能特征	4
4	声学特性	6
4.1	自由场频率响应	7
5	电气特性及参数	8
5.1	绝对最大额定值	8
5.2	电气特性	8
5.3	电气参数	9
6	封装信息	10
7	焊盘和钢网模版推荐	11
8	包装信息	12
9	回流焊和电路板组装	13
10	可靠性规格	15
10.1	环境鲁棒性	16
	修订记录	17
	免责声明	18

1 框图

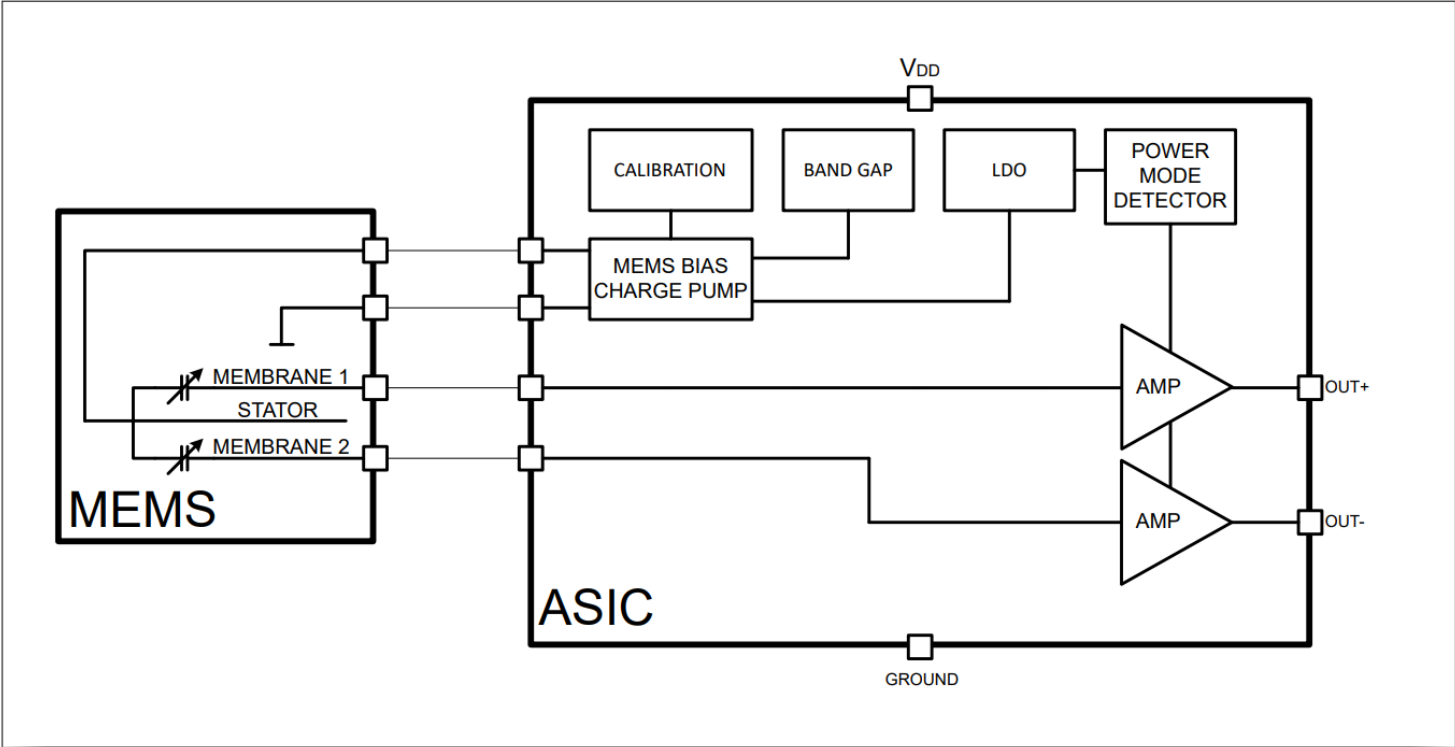


图1 IM70A135V01框图

2 典型的麦克风接口

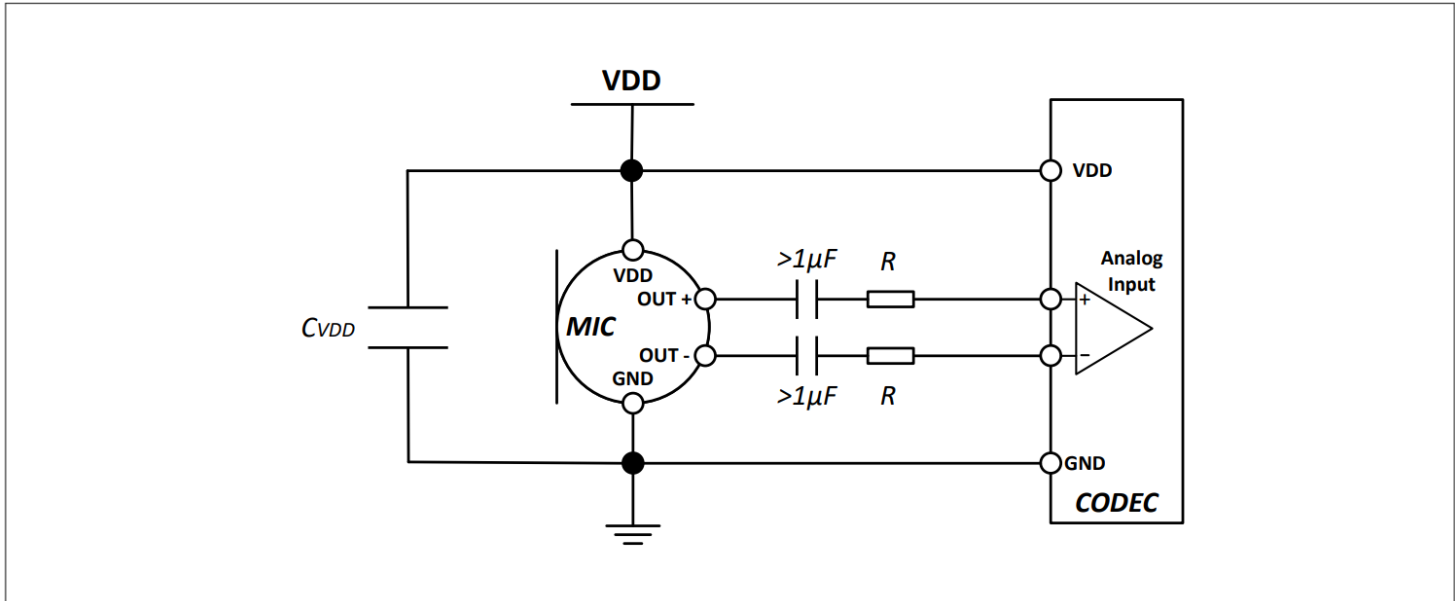


图2 差分模拟麦克风接口示例

注意： 电源滤波电容应尽可能靠近麦克风放置。有关电气、声学 and 机械执行的详细信息，请参阅 XENSIV™ MEMS 麦克风[网页](#)上的应用说明。

3 典型性能特征

测试条件（除非另有说明）： $V_{DD} = 2.75V$ ， $T_A = 25^{\circ}C$ ，输出无负载

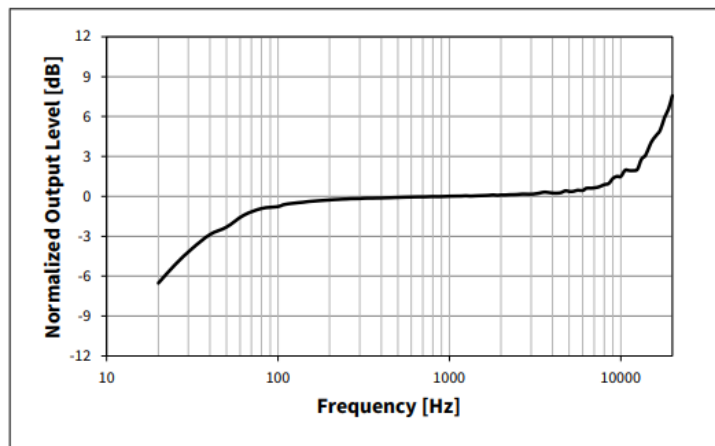


Figure 3 Typical amplitude response

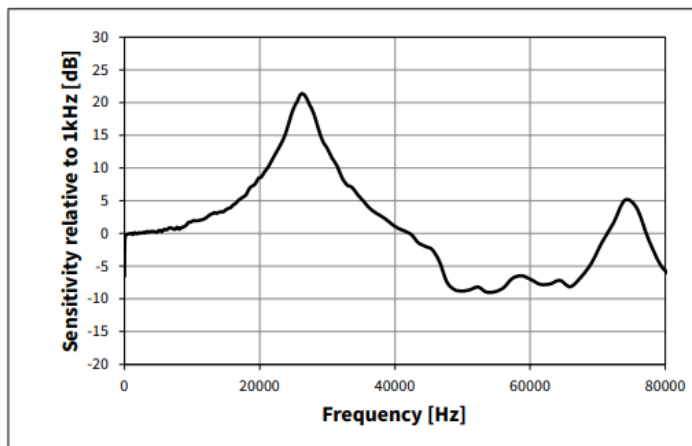


Figure 4 Typical ultrasonic response

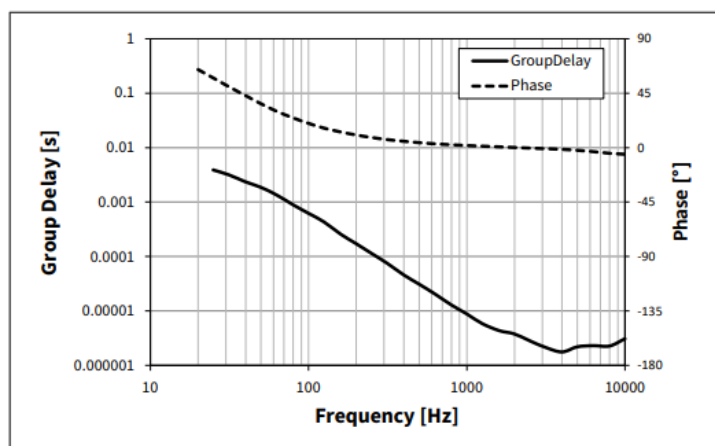


Figure 5 Typical group delay and phase response

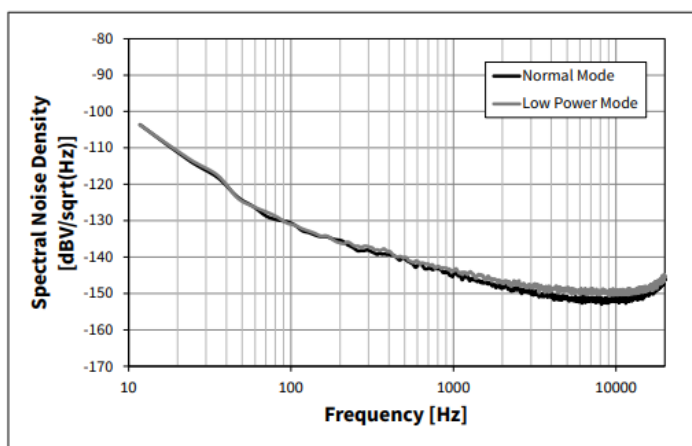


Figure 6 Typical noise floor (unweighted)

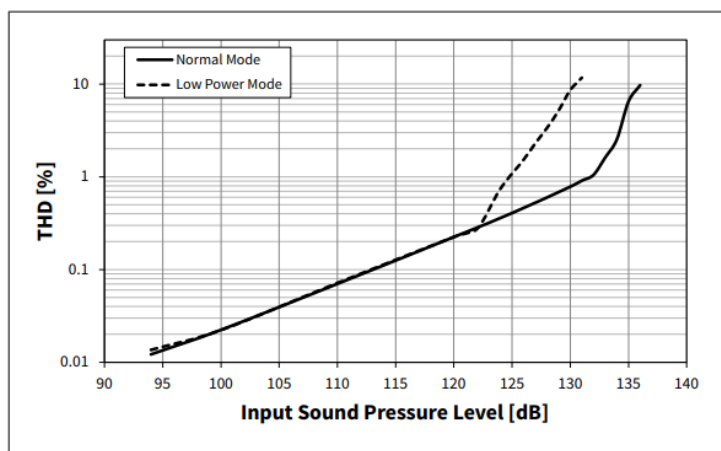


Figure 7 Typical THD vs SPL

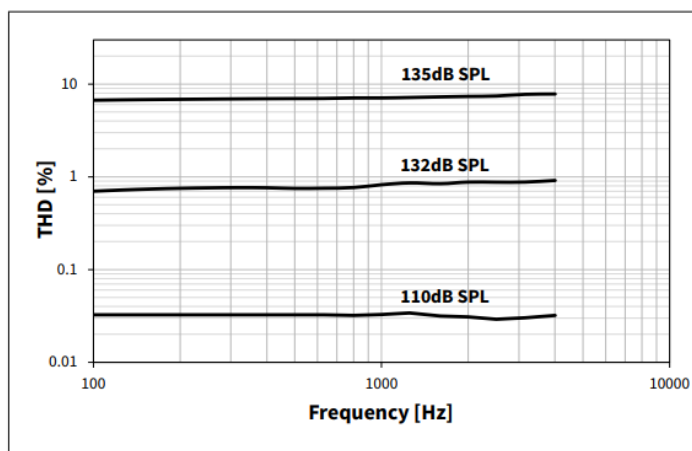


Figure 8 Typical THD vs frequency

3 典型性能特征

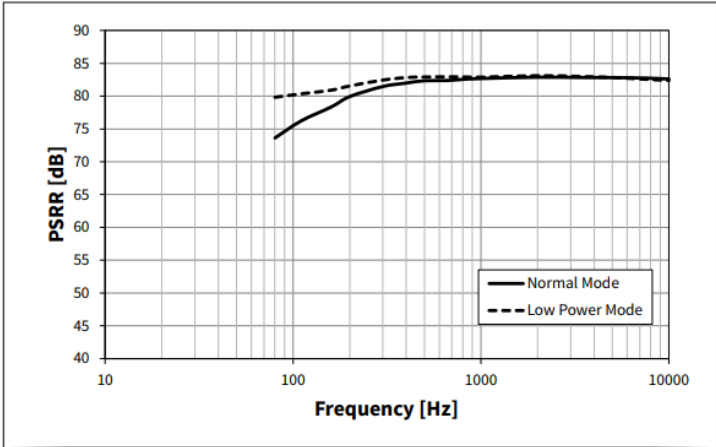


Figure 9 Typical PSRR

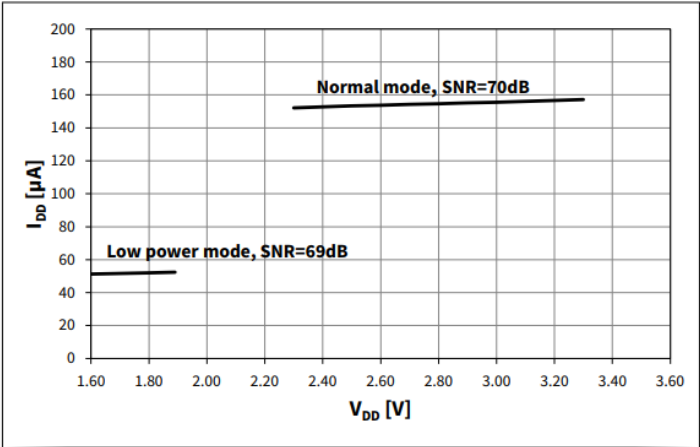


Figure 10 Typical I_{DD} vs V_{DD}

4 声学特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 2.75V$ 、 $T_A = 25^{\circ}C$ 、55% RH、音频带宽 20Hz 至 20kHz、输出无负载

表1 IM70A135V01声学规格

Parameter			Symbol	Values			Unit	Note or test condition
				Min.	Typ.	Max.		
Sensitivity			S	-39	-38	-37	dBV	1kHz, 94 dB SPL, all operating modes
Low Frequency Roll-off			f _{C LP}		37		Hz	-3dB point relative to 1kHz
Signal to Noise Ratio	Normal mode		SNR _{NP}		70		dB(A)	A-Weighted
	Low power mode		SNR _{LP}		69			
Total Harmonic Distortion	Normal mode	94dBSPL	THD _{NP}			0.3	%	Measuring 2nd to 5th harmonics, 1kHz, Sensitivity=typical
		132dBSPL			1.0			
	Low power mode	94dBSPL	THD _{LP}			0.3		
		124dBSPL			1.0			
Acoustic Overload Point (Typical THD = 10%)	Normal mode		AOP _{NP}		135		dBSPL	
	Low power mode		AOP _{LP}		130			
Phase Response	75Hz				25		°	
	1kHz				2			
	4kHz				-2			
Group Delay	250Hz				125		μs	
	600Hz				22			
	1kHz				8			
	4kHz				1			
Directivity				Omnidirectional				Pickup pattern
Polarity				Increasing Vout				Increasing SPL

4.1 自由场频率响应

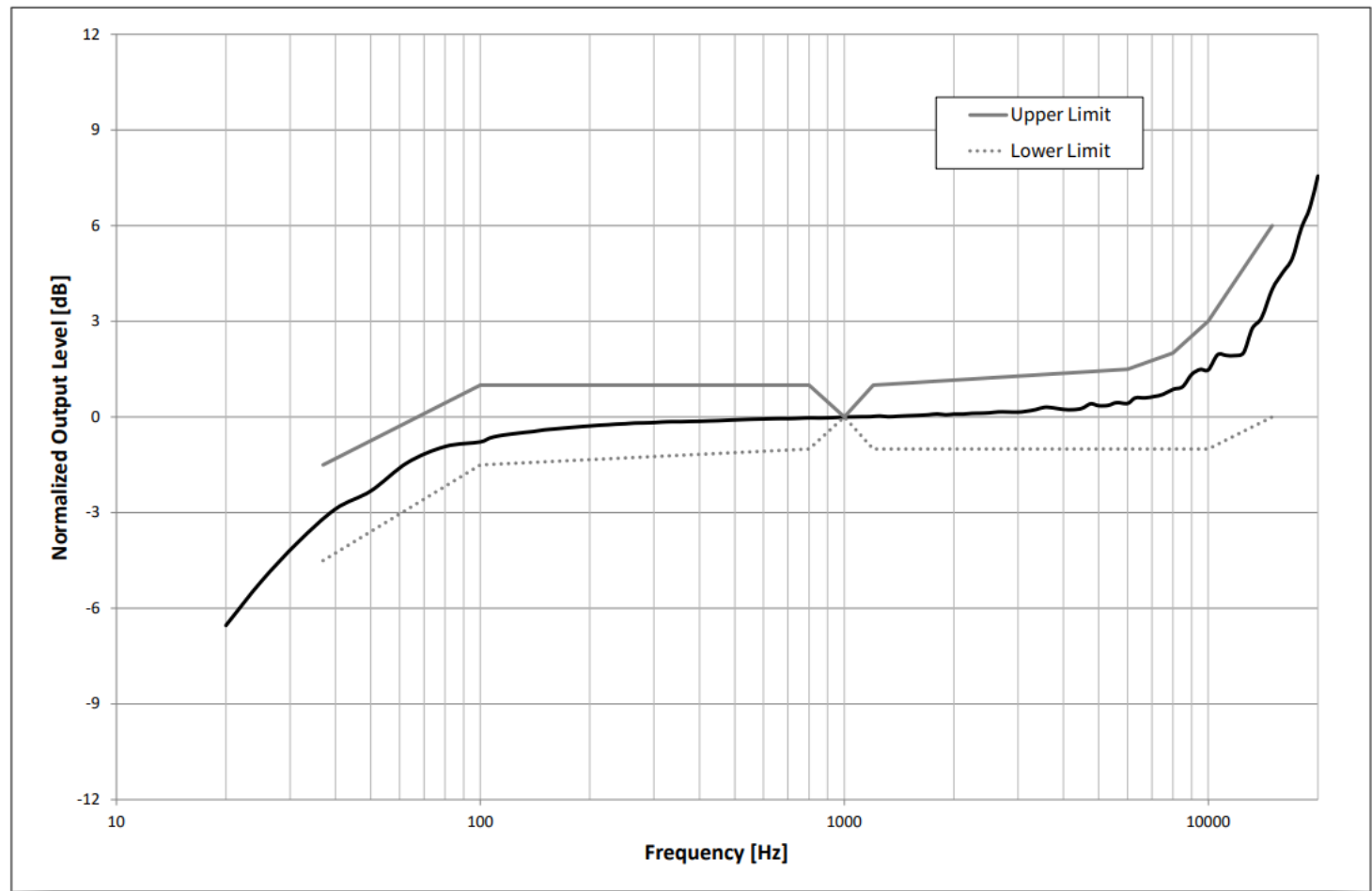


图11 IM70A135V01自由场频率响应

表2 IM70A135V01自由场频率响应，归一化至1kHz灵敏度值

Frequency [Hz]	Upper limit [dB]	Lower limit [dB]
37	-1.5	-4.5
100	1	-1.5
300	1	-1
1000	0	0
6000	1.5	-1
8000	2	-1
10000	3	-1
15000	6	0

5 电气特性及参数

5 电气特性及参数

5.1 绝对最大额定值

超过所列最大额定值运行器件可能会影响器件可靠性或导致器件永久性损坏。在这些条件下，无法保证器件正常运行。

Table 3 Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Values		Unit	Note / Test Condition
		Min.	Max.		
Supply voltage	V_{DDmax}		3.0	V	
Storage temperature	T_S	-40	100	°C	
Operating temperature	T_A	-40	85	°C	

5.2 电气特性

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 2.75V$ ， $T_A = 25^\circ C$ ，55% R.H。

Table 4 IM70A135V01 electrical characteristics

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Current consumption	Normal mode	I_{DDNP}		170	230	μA	Input ≤ 94 dB SPL
	Low power mode	$I_{DDL P}$		70	80		
Start-up time		$t_{startup}$		10	30	ms	Start-up time in all operating modes after V_{DDmin} is applied
Mode switching time		$t_{ModeChange}$		10		ms	Time of undefined output after mode change detected
Brown out voltage		$V_{BrownOut}$		1.2		V	Brown out is triggered for voltage below $V_{BrownOut}$
Vout DC-voltage	Normal mode	$V_{OUT_DC_NP}$		1.35		V	
	Low power mode	$V_{OUT_DC_LP}$		0.9			
Power supply rejection ratio in band (differential)	Normal mode	$PSRR_{InBand_N P}$		80		dB	$V_{DD} = 2.75V + 100mV_{pp}$ sinewave
	Low power mode	$PSRR_{InBand_L P}$		80			$V_{DD} = 1.6V + 100mV_{pp}$ sinewave
Power supply rejection ratio common mode	Normal mode	$PSRR_{CM_NP}$		65		dB	$V_{DD} = 2.75V + 100mV_{pp}$ sinewave
	Low power mode	$PSRR_{CM_LP}$		60			$V_{DD} = 1.6V + 100mV_{pp}$ sinewave
Output impedance	Normal mode	Z_{out_NP}			250	Ω	
	Low power mode	Z_{out_LP}			500	Ω	

5.3 电气参数

表5 IM70A135V01电气参数

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Supply voltage	Normal mode	VDD	2.3	2.75	3.0	V	A 100nF bypass capacitor(C_{VDD}) should be placed close to the microphone V_{DD} pin to ensure best SNR performance
	Low power mode		1.52	1.6	1.8		
V_{DD} ramp-up time					1	ms	V_{DD} reaches its final value within $\pm 10\%$ tolerance
Output load	C_{load}				100	pF	
	R_{load}			25		k Ω	

6 封装信息

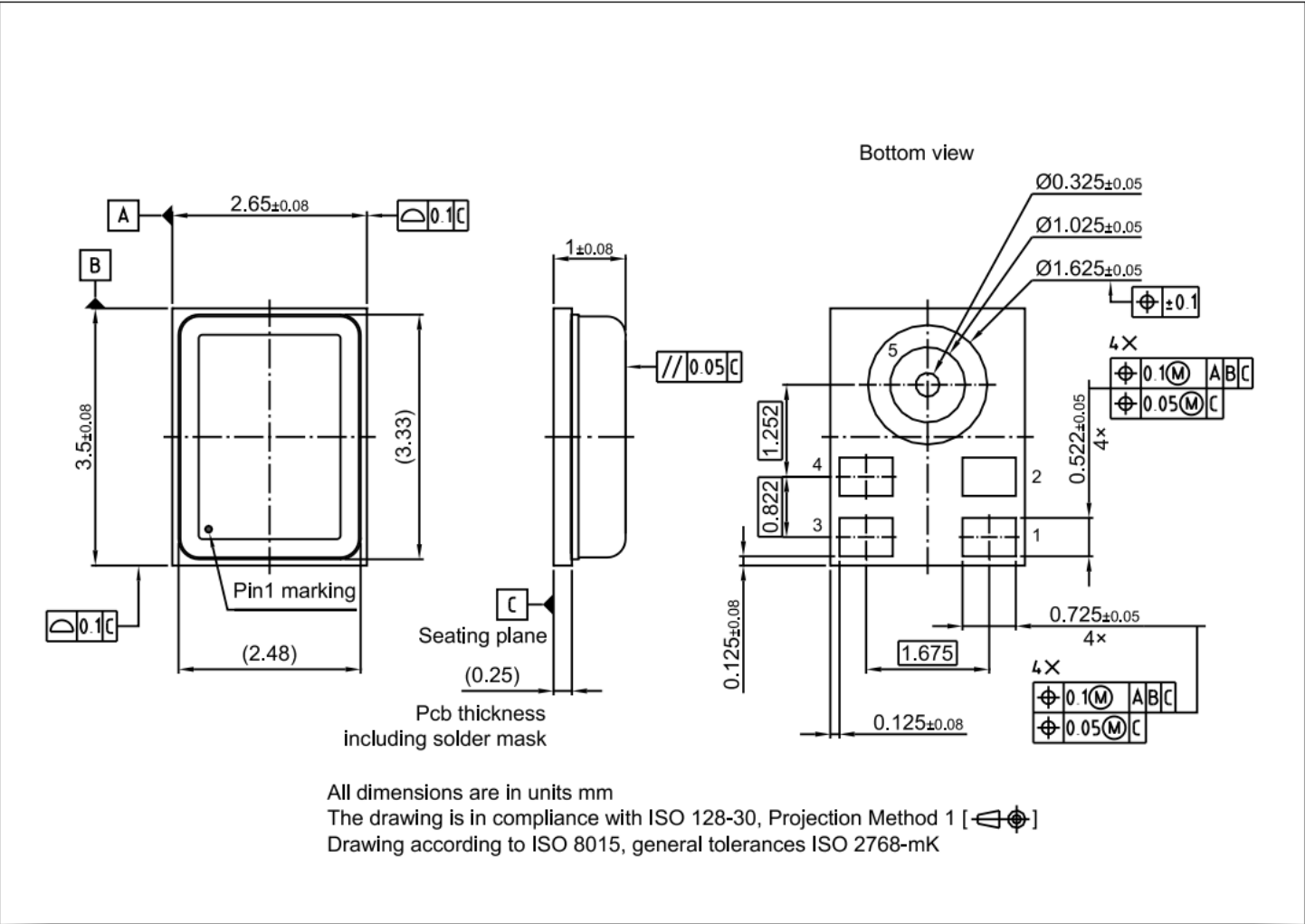


图12 IM70A135V01封装图

表6 IM70A135V01引脚配置

Pin Number	Name	Description
1	V_{DD}	Power supply
2	GND	Ground
3	Output +	Differential Output +
4	Output -	Differential Output -
5	GND	Ground

7 焊盘和钢网模板推荐

为保证最优性能，PCB 上的声孔直径应大于 MEMS 麦克风的声孔直径。建议的 PCB 声孔直径为 0.6 毫米。

如图13所示的电路板焊盘和钢网模板孔径建议基于阻焊定义 (SMD) 焊盘。应考虑电路板制造商的具体设计规则，以进行个别设计的优化或调整。

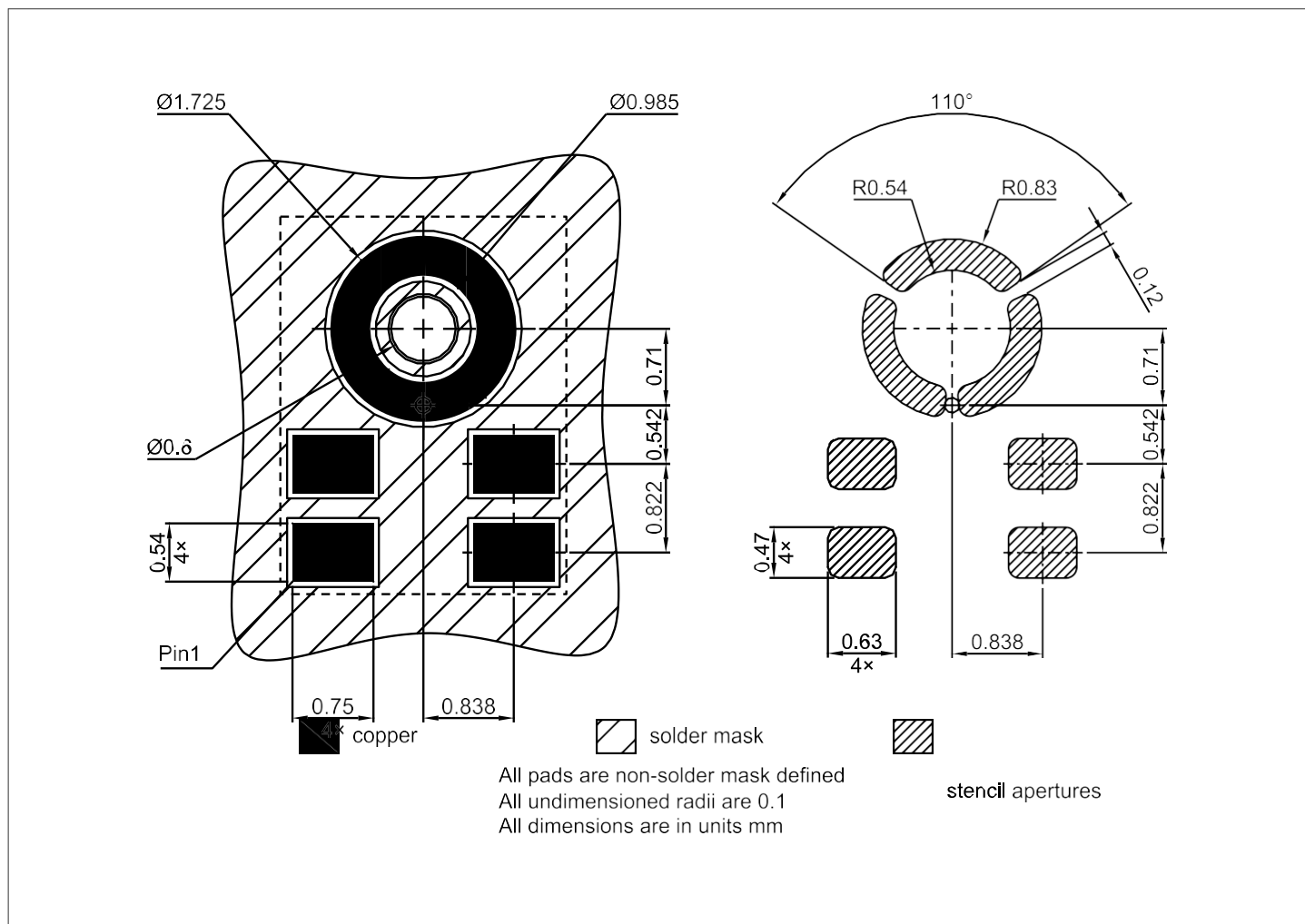


Figure 13 **Footprint and stencil recommendation**

8 包装信息

为了便于运输和组装，英飞凌麦克风采用专用的卷带式载带进行包装。载带的详细图纸如图 14 所示

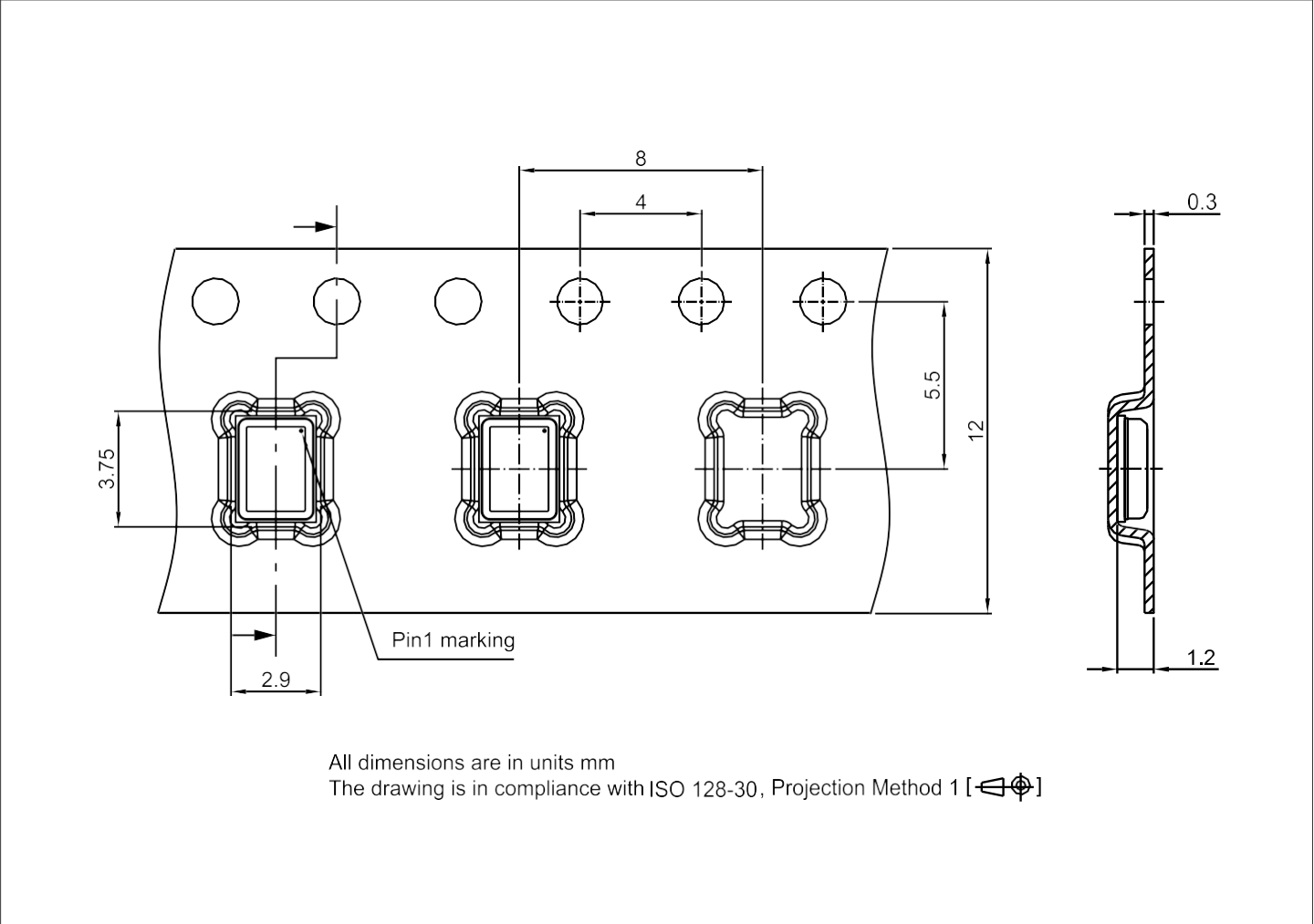


Figure 14 IM70A135V01 tape and reel packing

information Table 7 IM70A135V01 packaging information

Product	Type code	Reel diameter	Quantity per reel
IM70A135V01	I70A13	13"	5000

9 回流焊和电路板组装

英飞凌 MEMS 麦克风符合 IPC/JEDEC J-STD-020D-01 标准。MEMS麦克风的湿气敏感性等级为MSL1。建议使用回流焊来进行MEMS麦克风的PCB组装。

为达到最优的焊接质量，回流温度曲线应与锡膏制造商的建议一致。推荐用图15所示的回流温度曲线 来生产包含英飞凌 MEMS 麦克风的电路板。

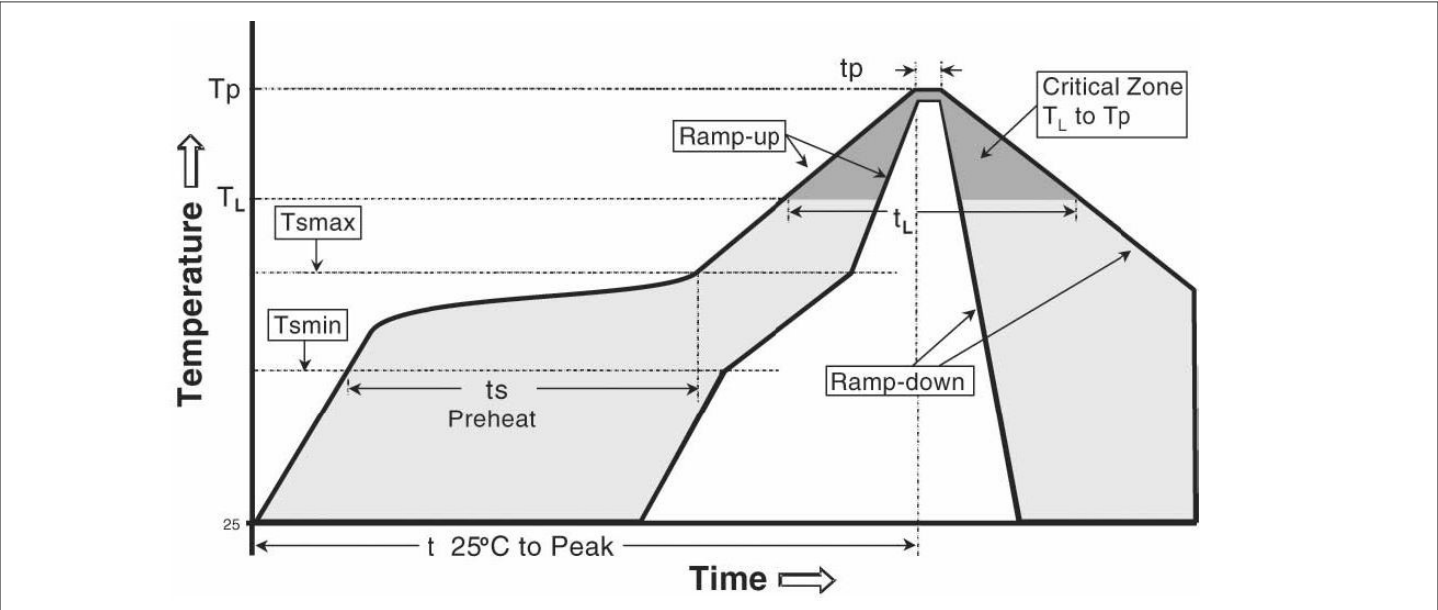


Figure 15 Recommended reflow

profile Table 8 Reflow profile limits

Profile feature	Pb-Free assembly	Sn-Pb Eutectic assembly
Temperature Min (T_{smin})	150 °C	100 °C
Temperature Max (T_{smax})	200 °C	150 °C
Time (T_{smin} to T_{smax}) (t_s)	60-120 seconds	60-120 seconds
Ramp-up rate (T_L to T_P)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T_L)	217 °C	183 °C
Time (t_L) maintained above T_L	60-150 seconds	60-150 seconds
Peak Temperature (T_P)	260°C +0°C/-5°C	235°C +0°C/-5°C
Time within 5°C of actual peak temperature (t_p) ¹⁾	20-40 seconds	10-30 seconds
Ramp-down rate	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.	6 minutes max.

1) 峰值温度 (T_P) 的公差定义为供应商的最小值和用户的最大值

注： 更多信息请参阅英飞凌科技网页上的“英飞凌封装组装的一般建议”文档

MEMS 麦克风可以使用行业标准的取放设备。应注意避免损坏麦克风结构，如下所示：

- 请勿使用接触麦克风声孔的真空工具拾取麦克风。
- 麦克风声孔不应暴露在真空中，否则会破坏 MEMS。
- 请勿将空气吹入麦克风声孔。如果采用吹气清洁工艺，则必须将声孔密封以防止颗粒物污染。
- 推荐在无尘室环境中进行 PCB 组装，以避免麦克风受到污染。
- 不应将吹气和超声波清洁工艺应用于 MEMS 麦克风。建议在组装时使用免清洗锡膏，以避免后续的清洁步骤。清洁物质可能会严重损坏麦克风的 MEMS。
- 为防止 PCB 组装时声孔被堵塞或部分堵塞，建议在 PCB 切割或系统组装时用保护胶带覆盖声孔。
- 将麦克风放置在 PCB 上时请勿用力过猛。建议使用行业标准的拾取和放置工具，以限制施加在封装上的机械力。

10 可靠性规格

测试后的麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过 3dB。

Table 9 Reliability specification

Test	Abbreviation	Test Condition	Standard
Low Temperature Operating Life	LTOL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
Low Temperature Storage Life	LTSL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A119
High Temperature Operation Life	HTOL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
High Temperature Storage Life	HTSL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A103
Temperature Cycling	PC + TC	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		1000 cycles, -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$, 30 minutes per cycle	JESD22-A104
Temperature Humidity Bias	PC + THB	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		$T_a = +85^{\circ}\text{C}$, R.H = 85%, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A101
Vibration Test	VF	20Hz to 2000Hz with a peak acceleration of 20g in X, Y, and Z for 4 minutes each, total 4 - cycles	IEC 60068-2-6
Mechanical Shock	MS	10000g/0.1msec direction $\pm x, y, z$, 5 shocks in each direction, 5 shocks in total	IEC 60068-2-27
Reflow Solder ¹⁾	RS	3 reflow cycles, peak temperature = $+260^{\circ}\text{C}$	IPC-JEDEC J-STD-020D-01
Electrostatic Discharge -System Level Test	ESD - SLT	3 discharges of $\pm 8\text{kV}$ direct contact to lid while V_{dd} is supplied according to the operational modes; (V_{dd} ground is separated from earth ground)	IEC-61000-4-2
Electrostatic Discharge - Human Body Model	ESD - HBM	1 pulse of $\pm 2\text{kV}$ between all I/O pin combinations	JEDEC-JS001
Electrostatic Discharge - Charged Device Model	ESD - CDM	3 discharges of $\pm 500\text{V}$ direct contact to I/O pins.	JEDEC JS-002

1) 经过3轮回流后，麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过1dB。

10.1 环境鲁棒性

英飞凌最新的密封双膜 MEMS 技术实现了麦克风级别的高等级防护 (IP57)。密封的 MEMS 设计可防止水或灰尘进入膜片和背板之间，从而防止 MEMS 麦克风常见的机械阻塞或电流泄漏问题。采用密封双膜技术制造的麦克风仅需要简单的防护即可用于 IP68 的产品中。

Table 10 Environmental robustness

Test Standard	Test Condition
IP5x dust resistance ¹⁾	Arizona dust A4 coarse, vertical orientation, sound hole upwards, 10 cycles (15 minutes sedimentation, 6 sec blowing)
IPx7 water immersion ²⁾	Temporary immersion of 1 meters for 30 minutes. Microphone tested 2 hours after removal

1) 数字“5”代表防尘等级或抵抗细小磨蚀性灰尘颗粒影响的能力。

2) “7”表示更高的耐水浸等级。



修订记录

修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
V1.00	2023-04-03	Initial datasheet



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-28

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG.

All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?

Email:

erratum@infineon.com

重要提示

本文件所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文件中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文件所提供的任何信息均取决于客户履行本文件所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文件所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文件中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。